ISSN 0234-5366

111-55

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH

N 1[27]-88

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ОИЯИ

JINR RAPID COMMUNICATIONS





Объединенный институт ядерных исследований Joint Institute for Nuclear Research

lf 1 [27]-88

KPATKNE COODEWEHNS ONSN JINR RAPID COMMUNICATIONS

сборник

COLLECTION



Дубна 1988

ОГЛАВЛЕНИЕ СОМТЕМТЅ

. .

M.K.Volkov, A.Schaale
Form Factors of the Decay $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$
М.К.Волков, А.Шаале
Формфакторы распада $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+ \dots + 4$
С.В.Афанасьев, П.И.Зарубин, И.Ф.Колпаков, В.С.Королев,
А.И.Малахов, П.К.Маньяков, А.С.Никифоров, А.Н.Парфенов,
А.В.Пиляр, В.А.Смирнов, Е.Хмелевски
Система в стандарте FASTBUS для измерения
аналоговых сигналов для спектрометра СФЕРА
S.V.Afanasiev, P.I.Zarubin, I.F.Kolpakov, V.S.Korolev, A.I.Malakhov,
P.K.Maniakov, A.S.Nikiforov, A.N.Parfenov, A.V.Pilyar, V.A.Smirnov,
E.Khmelevsky
FASTBUS System for Measurement of Analogue
Signals for SPHERE Spectrometer
Я.Ваврыцук, Т.Говорек, А.И.Иванов, М.Левандовски,
П.Мазурек, В.Н.Рыбаков, И.Ф.Учеваткин, И.А.Ютландов
Аннигиляция позитронов
в высокотемпературном сверхпроводнике $ ext{Y} \operatorname{Ba}_2\operatorname{Cu}_3\operatorname{O}_{7-\delta}$
Ya.Vavryshchyuk, T.Govorek, A.I.Ivanov, M.Levandovsky,
P.Masurek, V.N.Rybakov, I.F.Uchevatkin, I.A.Yutlandov
Positron Annihilation in a High-Temperature
Superconductor Y $Ba_2 Cu_3 O_{7-\delta} \dots 12$
Нгуен Ван Хьеу, Нгуен Ан Вьет
Трехзонные экситонные поляритоны в кубических
полупроводниках с прямой запрещенной зоной
н их комбинационное рассеяние
Nguyen Van Hieu, Nguyen Ai Viet
Three-Branch Excitonic Polaritons in Cubic Direct Band
Gap Semiconductors and Their Raman Scattering
Указатель статей к сборникам
"Краткие сообщения ОИЯИ", 1 (21) -6 (26), 1987
JINR Rapid Communications 1(21)-6(26), 1987 23
Именной указатель к сборникам
"Краткие сообщения ОИЯИ" 1 (21) -6 (26), 1987
Author Index, 1987

Краткие сообщения ОИЯИ №1 [27] -88 УДК 539.12.01:539.126.3

FORM FACTORS OF THE DECAY $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$

M.K.Volkov, A.Schaale*

The decay $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$ is studied in the quark model of superconductivity type. The calculated form factors R and the relation $\xi = R/F_v$ are in a good agreement with experimental data.

The investigation has been performed at the Laboratory of Theoretical Physics, JINR.

Формфакторы распада $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$

М.К.Волков, А.Шаале

В квирковой модели сверхпроводящего типа описан распад $\pi^+ \to e^+e^- \nu e^+$. Полученные оценки для формфактора R и отношение $\xi = \mathbf{R}/\mathbf{F}_{\mathbf{v}}$ согласуются с экспериментом.

Работ: выполнена в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.

In¹¹, based on the Quark-Model of Superconductor Type¹²/ the form factors (vectorial and axial) were calculated for the decay $\pi \to e^-\bar{\nu}\gamma$. It has been shown that for a 1-mesons, the relation $\gamma = F_A/F_V = Z^{-1}$ becomes less than one ($Z^{-1} = 0.7$), where $Z^{-1} = 1 - 6m_u^2/m_{a_1}^2$, $m_u = 280$ MeV is the mass of the u-quark in QMST and $m_{a_1} = 1275$ MeV is the mass of the a1-meson. This result for γ is in good agreement with experimental data^{13-5/}. Some time ago new experimental data were published by the group SINDRUM^{5/} for the decay $\pi^+ \to e^+e^- \nu e^+$, where besides the well-known form factors F_A and F_V also the axial form factor R appeared, connected with the momentum of the e^+e^- -pair. Therefor it is useful to calculate R and the relation $\xi = R/F_V$ that is also determind experimentally. In^{5/} the following results are given for the form factors:

$$F_{V} = 0.029^{+}_{-}0.019, \quad F_{A} = 0.018^{+}_{-}0.015, \quad R = 0.063^{+}_{-}0.016, \quad (1)$$

$$\gamma = 0.7 \pm 0.5, \quad \xi = 2.3 \pm 0.6.$$

^{*}Institute for High Energy Physics, Berlin, Zeuthen, GDR

Using $\frac{\theta}{\theta}$ for determining the structure part of the amplitude $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$ one gets:

$$T_{(\pi^{+} \rightarrow e^{+}e^{-}\nu e^{+})}^{s} = ie^{2} Q \frac{1}{k^{2}m_{\pi}^{2}} F_{\pi} \ell_{a}^{em} \{F_{\nu} \epsilon_{a}\beta_{\mu\nu} k^{\mu} Q^{\nu} + iF_{A} (Q_{a} k_{\beta} - g_{a\beta} Qk) + iR(k_{a} k_{\beta} - g_{a\beta} k^{2})\} \ell_{\beta}^{w}, \qquad (2)$$

where G is the Fermi constant, **e** is the charge of the electron; \mathbf{F}_{π} , the constant of pion-decay $\mathbf{F}_{\pi} = 93 \text{ MeV}$; ℓ_{a}^{em} , the electromagnetic current $\ell_{a}^{\text{em}} = \bar{\mathbf{u}}_{e}(\mathbf{p}_{3}) \gamma_{a} \mathbf{u}_{e}(-\mathbf{p}_{2})$; ℓ_{β}^{w} , the weak current $\ell_{\beta}^{\text{em}} = \bar{\mathbf{u}}_{\nu}(\mathbf{p}) \times \gamma_{\beta}(1-\gamma_{5}) \mathbf{u}_{e}(-\mathbf{p}_{1})$; G, the momentum of the pair $\mathbf{e}^{+}\nu$ and k is the momentum of the pair $\mathbf{e}^{+}\mathbf{e}^{-}$. Only the diagrams in the Figure contribute to the amplitude (2), where the \mathbf{a}_{1} -meson playes an important



Diagrams of the decay $\pi^+ \rightarrow e^+ e^- \nu e^+$.

role as an intermediate particle. If only diagram (a) is used, then F_A and F_v will be equal:

$$F_{A}^{a} = F_{V}^{a} = \frac{1}{8\pi^{2}} \frac{m_{\pi}^{2}}{F_{\pi}^{2}}, \quad \gamma = 1.$$
(3)

Using also diagram (b) we finally get for the form factors F_V and F_A the expression/1/: $F_V^{a+b} = F_V^{a}$, $F_A^{a+b} = F_A^{a}Z^{-1}$, $y = Z^{-1}$. This result agrees with the experimental (see (1)). It will be shown that the influence of diagram (b) is the same for the form factor $R : R^{a+b} = R^a$, Z^{-1} . The form factor R is absent in the decay $\pi^- \rightarrow e^- \bar{\nu} y$ because $k^2 = 0$ for the photon, but when the e^+e^- -pair appears, $k^2 \neq 0$ and there occurs a k^2 -dependence in the amplitude (2) (form factor R).

For the calculation of R, the amplitude for the decay $\pi_1 \rightarrow \pi \rho$ will be used, taken from $^{1/2}$:

$$T^{\mu\nu}_{(a_1 \to \pi\rho)} = i \frac{g^2_{\rho}}{8\pi^2 F_{\pi}} \{ p^{\mu} k^{\nu} - g^{\mu\nu} pk + [1 + 2Z(\frac{2\pi F_{\pi}}{m_{a_1}})^2] g^{\mu\nu} k^2 \}.$$
(4)

Here \mathbf{g}_{ρ} is the constant of the decay $\rho \rightarrow 2\pi$ with $\mathbf{g}_{\rho}^{2}/4\pi \approx 3$, \mathbf{p} and \mathbf{k} are the momenta of the pion and the ρ -meson. Before using this expression for calculating the axial part of the amplitude (2) it is necessary to substitute $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}$. If we use only diagram (a) for the calculation of R, we get:

$$\mathbf{R}^{a} = \frac{1}{8\pi^2} \cdot \frac{m_{\pi}^2}{F_{\pi}^2} 2(1 + Z(\frac{2\pi F_{\pi}}{m_{a_1}})^2) = F_V 2(1 + Z(\frac{2\pi F_{\pi}}{m_{a_1}})^2)$$

but, finally using both the diagrams, (a) and (b), we get for the form factor R and the relation ξ the following expressions:

$$\mathbf{R}^{\mathbf{a}+\mathbf{b}} = \mathbf{R} = \mathbf{F}_{\mathbf{V}}^{2} (\mathbf{Z}^{-1} + (\frac{2\pi \mathbf{F}_{\pi}}{\mathbf{m}_{\mathbf{a}}})^{2}) = 0.053, \ \xi = 2(\mathbf{Z}^{-1} + (\frac{2\pi \mathbf{F}_{\pi}}{\mathbf{m}_{\mathbf{a}}})^{2}) = 1.83.$$

These theoretical results agree with the experimental data (1) (remind that theoretical values for F_V and F_A are: $F_V = 0.029$ and $F_A = 0.020^{/1/}$). At the end of this short report we wish to compare our results with those of the Quark-Virton Model $^{/?/}$:

$$F_V = 0.041$$
 $F_A = 0.023$, $R = 0.087$, $\gamma = 0.56$, $\xi = 2.1$.

In that model there was also taken into account the a_1 -meson.

A comparison of the values we have obtained for the form factors F_V , F_A and R shows that our prediction in the QMST is slightly better than that in $7^{7/2}$ (see (1)). The expressions for the form factors in the QMST are analytically very simple so it is easy to compare them with the results of other models, for example, with the standard Quark Models $F_V = F_A = \frac{m_V^2/8\pi^2}{\pi} F_T^{2/8/2}$. It is possible to show here that the intermediate a_1 -meson plays a very important role only for an exact calculation of the form factor F_A and the ratio γ which is in a good agreement with the experimental data (γ becomes less than one ($\gamma = 0.7$) under the influence of the a_1 -meson). The value of R slightly changes after taking into account of the a_1 -meson.

References

^{1.} Volkov M.K. et al. JINR Preprint P2-87-89, Dubna, 1987; Phys.Lett., 1988, B200.

- 2. Volkov M.K. El. Part. a. At. Nucl., 1986, 17, p.433.
- 3. Bay A. et al. Phys.Lett., 1986, 174B, p.445.
- 4. Piilonen L.E. et al. Phys. Rev. Lett., 1986, 57, p.1402.
- 5. Egli S. et al. Phys. Lett., 1986, 175B, p.97.
- 6. Bardin D.Y., Ivanov E.A. El. Part. a. At. Nucl., 1976, 7, p.726.
- 7. Avacian E.Z. et al. JINR Preprint P2-87-485, Dubna, 1987.
- 8. Bryman D.A., Depommier P., Lecroy C. Phys. Rep., 1982, 88, p. '51; Paver N., Scadron M.D. – Nuovo Cim., 1983, A 78, p. 159.

Received on November 9, 1987.

СИСТЕМА В СТАНДАРТЕ FASTBUS ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА СФЕРА

С.В.Афанасьев, П.И.Зарубин, И.Ф.Колпаков, В.С.Королев, А.И.Малахов, П.К.Маньяков, А.С.Никифоров, А.Н.Парфенов, А.В.Пиляр, В.А.Смирнов, Е.Хмелевски

Рассматривается система в стандарте FASTBUS для измерения быстрых аналоговых сигналов на установке СФЕРА. Система пострсена на основе 16-канального 8-разрядного АЦП в стандарте FASTBUS, стандартного интерфейсного модуля FIORI и сопряжен ых с ним регистров, осуществляющих обмен данными между илгистралями FASTBUS и КАМАК. Работой системы управляет микроЭВМ "Электроника-60", связанная через контроллер с магистралью крейта КАМАК. Программное обеспечение, применен ое в системе, позволяет осуществить связь ЭВМ с магистралью FASTBUS, тестирование модулей, сбор и обработку данных, а также представление результата в виде гистограммы. Данлая система применена на стенде установки СФЕРА для снятия сарактеристик сцинтилляционных годоскопов.

Р юта выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

FASTBUS System for Measurement of Analogue Signals for SPHERE Spectrometer

S.V. Afanasiev et al.

A FASTBUS system for measurement of analogue signals at SPHERE experiment stand is described. The system based on 16-channel 8-bit flash ADC FASTBUS module, standard FIORI interface module connected with CAMAC input/output registers realizes data transfer between FASTBUS and CAMAC dataways. Operation of the system is controlled by "Elektronika-60" microcomputer connected to the CAMAC crate controller. Software used in the system permits one to realize communication between FASTBUS dataway and computer, mod lle testing, data acquisition and processing, and the result representation as a histogram. The described system was applied at the stand of SPHERE experiment for measuring the characteristics of scintillation hodoscope.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

1. ВВЕДЕНИЕ

Регистрирующая аппаратура современных спектрометров, применяемая в области физики элементарных частиц, как правило, выполняется в стандарте FASTBUS^{/1/}. Число регистрирующих каналов существующих и создаваемых спектрометров достигает десятков и сотен тысяч. Шина FASTBUS имеет наибольшее быстродействие из существующих 32-разрядных шин — до ''0 Мбайт/с и обеспечивает регистрацию потоков событий до 10⁷ в секунду. Архитектура системы FASTBUS позволяет организовать модульным образом практически любые сверхбольшие системы при самой низкой, по сравнению с другими стандартами, стоимости канала регистрации^{/2/}.

В Лаборатории высоких энергий ОИЯИ в настоящее время создается ряд современных экспериментальных установок, предназначенных для исследований в области физики высоких энергий, в которых предполагается широкое использование электроники в стандарте FASTBUS. Первые разработки в этом стандарте были применены в спектрометре СФЕРА, предназначенном для исследования множественного кумулятивного рождения частиц в геометрии, близкой к $4\pi^{/3/}$.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В связи с низким выходом изучаемых процессов установка СФЕРА должна регистрировать высокие интенсивности пучков



частиц $(10^9 \div 10^{11} \text{ частиц/с})$. что предъявляет повышенные требования к временхаракт эристикам ным агларатуры. электронной Наличие в установке нескольких тысяч информаканалон разного пионных типа требует нового подхода при разработке электроники съема данных. Из всех существующих (тандартов наиболее подходящим для

Рис. 1. Блок-схема системы в стандарте FASTBUS для измерения аналоговых сигналов на установке СФЕРА.

9

решения задач быстрого съема и отбора событий в этой установке является FASTBUS. На основе этого стандарта была разработана система для измерений аналоговых сигналов на установке СФЕРА (рис.1). Быстрые аналоговые сигналы преобразуются в цифровые коды 16-канальным 8-разрядным аналого-цифровым преобразователем, выполненным в стандарте FASTBUS. Диапазон измеряемых аналого-цифровым преобразователем (АЦП) сигналов составляет ±2 В, время преобразования ~ 40 нс. Считывание информации из АЦП по шине FASTBUS производится регистром вводавывода FIORI^{/4/} одновременно с двух каналов. Этот модуль реализует прогокол управления и передачи данных по магистрали для сегмента (крейта) FASTBUS и осуществляет связь с внешней Передача данных и управляющих модулем FIORI функ-ЭВМ. ций производится через два 16-разрядных двунаправленных регистра ФДЕ, выполненных в стандарте КАМАК. В реализованной в настоящее время схеме связи магистралей FASTBUS и КАМАК элементом управления процессом обмена является микроЭВМ "Электроника-60". Она связана с магистралью крейта КАМАК, котором расположены модули ФДР, через драйвер ветви в ИВМ-861^{/5}, и контроллер крейта типа А. Минимальное время доступа к сегменту FASTBUS, полученное в системе, составило ~ 60 мкс, что обусловлено низким быстродействием ЭВМ и FIORI, иля которого требуется несколько циклов КАМАК на одну команду. Полное время обработки данных составляет 1÷3 мс, что хорошо согласуется с временными характеристиками подобных систем/7/.

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение системы имеет двухуровневую структуру, позволяющую разделить задачи сбора информации, оперативного управления, обработки и представления результата. На более высоком уровне сбора информации и управления программа работает как оперативная задача операционной системы RT-11. При этом она осуществляет инициализацию модулей, связь ЭВМ с АЦИ по протоколу FASTBUS, тестирование и подготовку данных для дальнейшей обработки, которая производится фоновой программой. Реализовать указанные возможности позволило использование комплекса программ гистограммирования MULTI-FB^{//3/}.

Система была использована для снятия характеристик модулей сцинтиляционных годоскопов установки СФЕРА. На рис.2 для иллюстрации приведен спектр, полученный от источника ⁹⁰Sr



со сцинтилляционного счетчика с радиатором на основе полистирола размерами 400х3х3 мм и световода из оргстекла длиной 1200 мм и сечением 3х3 мм².

Рис.2. Амплитудный спектр, полученный от источчика ⁹⁰Sr с одного из счетчиков сцинтилляционного годоскопа спектрометра СФЕРА.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из сказанного видно, что дальнейшее повышение быстродействия системы может быть получено путем применения более быстрой аппаратуры связи с ЭВМ, а также использования быстрых интерфейсов FASTBUS, быстродействующих запоминающих устройств и производительных микропроцесссров (например, MC-68020).

Опыт разработки данной системы и модулей FAS'. BUS может быть использован для создания нового поколения спектрометров в физике элементарных частиц, в частности универсального калориметрического детектора на встречных пучках УНК в Серпухове.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. IEEE Standard FASTBUS Modular High-Speed Date Acquisition and Control System, ANSI/IEEE Std 960 1986, 1985.
- W.von Rüden. 1986 CERN School of Computing. CERN 87-04, Geneva, 1987, p.100.
- 3. Аверичев С.А. и др. ОИЯИ, Р1-85-512, Дубна, 1985.
- 4. FASTBUS Products (Dr. B.Struck). Hamburg, W.Germany, 1986.
- 5. Смирнов В.А., Хоанг Као Зунг. ОИЯИ, 10-81-528, Дубна, 1981.
- 6. Никифоров А.С., Смирнов В.А. ОИЯИ, Р10-87-650, Дубна, 1987
- 7. Rimmer E.M. IEEE Trans. on Nucl. Sci., 1983, vol.NS-30, No.5, p. 3968.

Рукопись поступила 7 января 1988 года.

Краткие сообщения ОИЯИ №1 [27] -88 УДК 538.945

АННИГИЛЯЩИЯ ПОЗИТРОНОВ В ВЫСОКОПЕМПЕРАТУРНОМ СВЕРХПРОВОДНИКЕ

Y Ba, Cu₃O₇₋₈

Я.Ваврыщу:<, Т.Говорек¹, А.И.Иванов², М.Левандовски, П.Мазурек¹, В.Н.Рыбаков, И.Ф.Учеваткин², И.А.Ютландов

Изучена аннигиляция поэитронов в образцах высокотемпературной сверхпроводящей керамики $Y \operatorname{Ba}_2 \operatorname{Cu}_3 \operatorname{O}_7 - \delta$. Показано, что изменение характера аннигиляции при переходе в сверхпроводящее состояние относительно невелико. Изменения времен жизни гозитронов r_1 и r_2 , а также интенсивности компоненты J_2 и допплеровского уширения аннигиляционной у-линии (параметра S) позволяют предполагать, что переход в сверхпроводящее состояние сопровождается некоторым уменьшением электронной плотности и уменьшением числа или увеличением размеро в дефектов кристаллической решетки.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Positron Annihilation in a High-Temperature Superconductor $Y Ba_2 Cu_3 O_7 - \delta$

Ya.Vavryshchyuk et al.

Positron annihilation as a function of temperature in high-temperature superconductors $Y Ba_2 Cu_3 O_{7-\delta}$ has been investigated. It is shown that a change in the annihilation capacity at the transition into superconducting state is relatively small. The change of r_1 and r_2 positron lifetimes as well as of the intensity of the component with $r_2 - J_2$ and Doppler broadening S parameter allows one to assume that transition into superconducting state is accompanied with a certain decrease in electron density and with decreasing number of defects or increasing size of crystalline net.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

¹ Институт физики Университета М.Кюри-Склодовской, Люблин, ² Всесою: ный научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Мендєлеева, Ленинград.

введение

Сверхпроводники типа La-Ba-Cu-O / 1 / в настоящее время интенсивно изучаются всеми доступными методами. Не является исключением и метод аннигиляции позитронов, особенно чувствительный к структуре вещества. Параметры, описывающие процесс аннигиляции (время жизни позитрона, ширина импульс-ного распределения электронов среды ^{/ 2/}), обычно существенно изменяются в точке фазового перехода. Несмотря на разочаровывающие результаты, полученные в пятидесятых годах при использовании обычных металлических сверхпроводников / 3-5/, представляется целесообразным проследить за поведением параметров аннигиляции в области перехода (Т с) высокотемпературных сверхпроводников. В первой такой работе /6 / использовалась техника измерения допплеровского уширения аннигиляционной у-линии 511 кэВ на образцах La-Sr-Cu-О и Y-Ba-Cu-О. В последующих экспериментах / ⁷,8 / для образцов Y – Ba – Cu – O кроме допплеровского уширения измерялись также времена жизни позитронов. Неоднозначность, а подчас противоречивость результатов этих работ делает настоятельно необходимым продолжение подобных исследований.

В настоящей работе представлены результаты измерения времен жизни позитронов в образцах $Y \operatorname{Ba}_2 \operatorname{Cu}_3 \operatorname{O}_{7-\delta}$ и допплеровского уширения аннигиляционной γ -линии в интервеле температур 80-130 К.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Измерения времен жизни позитронов проводились с помощью временного спектрометра $\gamma\gamma$ -совпадений с двумя кристаллами BaF₂ размером Ø 38х25 мм. Энергетическое разрешение обоих сцинтилляторов с фотоумножителями XP2020Q на линии 1333 кэВ ⁶⁰ Со составляло 7%. Для устранения искажений формы временного спектра при больших загрузках в цепи отбора совпадений были включены блоки, отбрасывающие импульсы наложений. В условиях эксперимента (при выборе γ -квантов 1274 и 511 кэВ) временное разрешение спектрометра составляло 2 $\tau_0 = 220$ пс. Форма кривой мгновенных совпадений, полученной с ⁶⁰ Со, соответствовала одному гаусювскому распределению вплоть до 0,001 доли полной ее высоты. Калибровка временной шкалы составляла 22,0 (1) пс/канал.

Допплеровское уширение аннигиляционной γ -линии 511 кэВ (параметр формы S) измерялось рентгеновским Ge(Li) детектором с объемом 1 см³ и энергетическим разрешением 1,02 кэВ на линии 512 кэВ ¹⁰⁸ Ru. Энергетическая цена

канала составляла 0,080 кэВ. Нестабильность положения линии 511 кэВ от измерения к измерению не превышала одного канала.

Для температурных измерений образцы $YBa_2O_3O_7 - \delta$ помещались в вакуумный криостат (p = 10⁻³ Topp) цилиндрической формы (Ø = 18 мм), охлаждаемый жидким азотом. Изменение температуры осуществлялось путем подогрева промежуточного полого мед юго цилиндра током, протекающим через намотанную на него бифилярным способом обмотку. В этот цилиндр вставлялся малый медный цилиндр, в прорези которого плотно размещался образец. Температура образца измерялась относительно температуры жидкого азота с помощью медь-константановой термопары. Напряжение, снимаемое с термопары, служило одновременно для стабили зации температуры (коррекции тока обмотки). Разработанная нами система стабилизации позволяла поддерживать постоянную температуру образца с точностью лучше 0,3 К в интервале 79-200 К

Источник позитронов активностью ~ 30 мкК был приготовлен из водного раствора ²²NaCl путем испарения на никелевой фольге толщиной 1,2 мкм, покрытой слоем эолота толщиной 50 Å. Площадь источника составляла ~ 8 мм².

Обрабстка временных спектров проводилась по программе POSITRONIIT⁹¹ на микроЭВМ типа IBM XT, входящей в состав измерительной аппаратуры. Поправка на аннигиляцию позитронов в никелевой подложке (~8%) не учитывалась. При этом подгоночным параметром считалось также временное разрешение спектромет за $2r_0$. Значения $2r_0$, получаемые из подгонки, находились в. пределах 222-225 пс. В каждом временном спектре зарегистрировано $\geq 1,2\cdot 10^6$ совпадений.

Для наблюдения изменений формы аннигиляционной у-линии с температурой образца вычислялся параметр S: отношение числа отсчетов в 14 каналах центральной части пика 511 кэВ к сумме отсчетов в двух окнах (по 18 каналов каждое), расположенных на сго левом и правом склонах.

ОБРАЗЦЫ $Y Ba_2 Cu_3 O_{7-\hat{\partial}}$

Исследуемые образцы были приготовлены путем спекания смеси окислов Y_2O_3 , BaO_2 , CuO в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ (образец № 1) и Y_2O_3 , $BaCO_3$, CuO - в Институте физики Университета М.Кюри-Склодовской в Люблине (образцы № 2 и № 3). Температура спекания 950°С, температуры сверхпроводящего перехода $T_c - 96$, 86 и 95 К соответственно. Характер зависимости R(T) позволял предположить, что все три образца не были однофазными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

В спектрах времен жизни позитронов в исследуемых образцах можно выделить три компоненты с $r_1 \approx 180$ пс, $r_2 \approx 350$ пс и $r_3 \approx 1,9$ нс. При этом интенсивность самой долгожив /щей компоненты J₃ не превышала 0,55%, а J₂ изменялась от образца к образцу в пределах от 8 до 17%. Попытки выделения только двух компонент приводили к существенному ухудшению приведенного χ^2 (с ~ 1,1 при трех компонентах до ~ 1,3 при двух) и значениям $r_1 \approx 190$ пс и $r_2 \approx 480$ пс. Так как в исследуемом диапазоне температур не было обнаружено изменений времени r_3 , окончательная обработка всех временных спектров проводилась при фиксированном усредненном значении этого параметра.

Проведенные нами измерения в диапазоне температур 80-130 К и при комнатной температуре показали, что изменение характера аннигиляции позитронов в наших образцах при их переходе в сверхпроводящее состояние относительно кебольшое. Наиболее четко оно проявилось на образце № 2 (см рисунок). Видно, что переход в сверхпроводящее состояние приводит к увеличению τ_1 и τ_2 , уменьшению интенсивности J_2 и параметра S.

Если считать, что компонента с т1 = 180 пс связана со свободной аннигиляцией позитронов в междуузельном пространстве, наблюдаемое небольшое увеличение т, при переходе образца в сверхпроводящее состояние может свидетельствовать о некоторой перестройке электронной структуры, приводящей к уменьшению электронной плотности. Компоненту с временем ro =350 пс, типичным для аннигиляции позитронов, захваченных дефектами кристаллической решетки, следует, по всей видимости, связать с кислородными вакансиями. Уменьшение интенсивности J₂ и параметра S при T < T, позволяет предположить, что количество этих дефектов в сверхпроводящем состоянии уменьшается. Увеличение т, можно связать с уменьшением электрснной плотности или увеличением размеров дефектов. Слабая компонента с временем $r_3 \simeq 1,9$ нс объясняется, по всей вероятности, образованием позитрония в пористой структуре металлооксидной керамики.

В работе^{/7} утверждается, что время жизни r_1 139±7 пс) не зависит от температуры образца; время жизни r_2 (~210 пс) при переходе образца в сверхпроводящее состояние заметно уменьшается, а J_2 (~30%) увеличивается. При этом странно, что параметр S в сверхпроводящем состоянии уменьшается, как и в наших экспериментах. Возможной причиной расхождения результатов работы^{/7}/с нашими является различие состава образцов.



Температурная зависимость параметров τ_1, τ_2, J_2 и S. Пунктирной линией обозначены средние значения параметров для областей выше и ниже T_c .

В экспериментах ^{/в/}исследовалось только допплеровское уширение аннигиляционной линии. Результаты по образцу Y-Ba-Cu-O не противоречат нашим данным.

В работе $^{/8}$ наблюдалось аномальное поведение величин r_1 , r_2 и J_2 в районе температуры T_c . Времена r_1 и r_2 показывают резкий максимум с полушириной ~1 К, а J_2 — глубокий минимум. При этом значения r_1 и r_2 выше и ниже T_c согласуются с на шими результатами в случае разложения временного

спектра на 2 компоненты. Кроме того, в работе ^{/8} / наблюдалось необычное увеличение времени термализации позитгона t_0 (на ~ 130 пс) при температуре T_c . Такое аномальное поведение аннигиляции не обнаружено ни в нашей работе, ни в работэ ^{/7} / Тем не менее нами был поставлен дополнительный эксперимент, имеющий целью детально проследить за изменением t_0 в зави симости от температуры образца № 2. Для этого регистрировалось число совпадений в окне, установленном на левом склоне временной кривой, при непрерывном изменении температуры образца со скоростью 1 в 4 минуты. Полученный результат позволяєт утверждать, что с точностью 20 пс t_0 в районе T_c остается постоянным.

Сравнение изложенных результатов позволяет сказать, что: а) переход образцов типа Y - Ba - Cu - O в сверхпроводящее состояние отражается на характере процесса аннигиляции позитронов; б) по всей вероятности, процесс аннигиляции позитронов чрезвычайно чувствителен к деталям внутренней стоуктуры образцов и технологии их приготовления. Это подтверждается противоположной температурной зависимостью r_2 , J_2 г данной работе и в 77/, а также их различными абсолютными значсниями.

Таким образом, есть надежда, что систематическое изучение аннигиляции позитронов в металлооксидных керамикак может помочь понять некоторые особенности механизма высо котемпературной сверхпроводимости и совершенствовать технологию изготовления сверхпроводников.

В заключение авторы выражают благодарность профессорам К.Я.Громову и Ц.Вылову за постоянный интерес и стимулирование настоящей работы, З.Скожинскому, А.К.Качалкину и А.И.Акатову за техническую помощь в постановке эксперимента.

Авторы также благодарят руководителя программы СРВР 01.09. ПНР за содействие в выполнении настоящего исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Bednorz J.C., Müller K.A. Z.Phys.B, 1986, v.64, p.189.
- 2. Positrons in solids, Ed. P. Hautojärve. Springer-Verlag, 1979, Chapter 1.
- 3. Stump R., Tally H.E. Phys. Rev., 1954, v.96, p.904.
- 4. Green B., Modansky L. Phys. Rev., 1956, v. 102, p. 1014.
- 5. Shafroth S.M., Marcus J.A. Phys. Rev., 1956, v. 103, p.585.
- 6. Ishibashi S. et al. Jap. J. Appl. Phys., 1987, v.26, p.L688.
- 7. Jean Y.C. et al. Phys. Rev. B, 1987, v.36, p.3994.
- 8. Teng M.-K. et al. Phys. Lett. A, 1987, v.124, p.363.
- 9. Kirkegaard P. et al. Comput. Phys. Commun., 1981, v.23, p.307.

Рукопись поступила 28 декабря 1987 года.

ТРЕХЗОННЫЕ ЭКСИТОННЫЕ ПОЛЯРИТОНЫ В КУБИ-ЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ С ПРЯМОЙ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНОЙ И ИХ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ

Нгуен Ван Хьеу, Нгуен Аи Вьет

Вынодятся явные выражения для операторов рождения трехзонных экситонных поляритонов в кубических полупроводниках с прямой запрещенной зоной и четырехкратно вырожденной верхней валентной зоной. В качестве примеров применения этих выражений устанавливаются соотношения между сечениями процессов резонансного комбинационного рассеяния поляризованного света квазичастицами в полупроводниках с данными свойствами симметрии.

Работа выполнена в Национальном центре научных исследований, Хиюй, СРВ.

Three Branch Excitonic Polaritons in Cubic Direct Band Gap Semiconductors and Their Raman Scattering

Nguyer Van Hieu, Nguyen Ai Viet

Explicit expressions are derived for the creation operators of the excitonic polaritons in direct band gap cubic semiconductors with a fourfold degenerate upper valence band. As examples of the application of these expressions the relations of the effective differential cross sections are established for the resonant Raman scattering of the polarized light on the quasiparticles in semiconductors with given symmetry properties.

The investigation has been performed at the National Center for Scientific Research, Hanoi, SRV.

Основополагающие труды Пекара¹¹, Хофильда², Аграновича³, Давыдова⁴, и др. по теории поляритонов вызвали большой интерес экспериментаторов и теоретиков, побудили их к изученико резонансного комбинационного рассеяния (РКР) света квазичастицами в твердых телах. В случае кубических полупроводников с прямой запрещенной зоной и четырехкратно вырожденной верхней валентной зоной спектр экситонных поляритонов обладает тремя ветвями вследствие того, что имеются два типа экситонов: связанных состояний электрона и легкой или тяжелой дырки. Законы дисперсии этих трехзонных экситонных поляритонов, установленные с большой точностью в эксперимен-

18

тах по РКР света фононами, находились в хорошем согласии с теоретическими предсказаниями $^{5/}$. Расчет сечения рассеяния также проводился в рамках различных упрощенных моделе $i^{5-7/}$. В настоящей работе для дальнейшего использования в микроскопической теории РКР света с учетом внутренней структуры экситонов и реальных свойств симметрии энергетических зон выводятся явные выражения, определяющие операторы гождения (или векторы состояния) трехзонных экситонных полиритонов в кубических полупроводниках с прямой запрещенной зоной и четырехкратно вырожденной верхней валентной зоной. Эти выражения затем применяются при изучении некоторых процессов РКР света в области резонанса. Выбираем систему единиц так, чтобы $\hbar = c = 1$.

Введем следующие обозначения: m_e, m_H и m_L -- эффективные массы электрона проводимости, тяжелой и легкой дырки соответственно:

 $\frac{1}{m_{\rm h}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m_{\rm H}} + \frac{1}{m_{\rm L}} \right), \quad M = m_{\rm e} + m_{\rm h},$

 $\frac{1}{m_{r}} = \frac{1}{m_{e}} + \frac{1}{m_{h}}$, $\alpha = \frac{m_{e}}{m_{h} + m_{e}}$, $\beta = \frac{m_{h}}{m_{h} + m_{e}}$;

 \vec{p}_{e} и \vec{p}_{h} — импульсы электрона и дырки, s_{e} и s_{h} — прсекции их спина на координатной оси Oz; $e_{s}^{+}(\vec{p})$ и $h_{s}^{+}(\vec{p})$ — операторы рождения электрона и дырки с указанными импульсом и проекцией спина на оси Oz , $\gamma_{\sigma}^{+}(\vec{k})$ — оператор рождения фотона с импульсом \vec{k} и спиральностью (проекцией спина на направлении импульса \vec{k}) $\sigma = \pm 1$; $D_{\lambda\lambda}^{J}$, $(\vec{p} \rightarrow \vec{q})$ — матричные элементы вращения, переводящего \vec{p} в \vec{q} , в базисе непризодимого представления с полным моментом импульса J. Достаточно рассматривать лишь экситоны в состоянии 1S с пространственной волновой функцией относительного движения электрона и дырки $\phi_{1,s}(\vec{p})$.

Имеются 4 спиновых состояния тяжелого экситов а со спиральностями ± 2 , ± 1 и 4 спиновых состояния легкого экситова со спиральностями ± 1 , 0, причем только спиновые состояния со спиральностями ± 1 могут смешиваться с фотоном для образования поляритов. На основе результатов работы^{/8/}можно показать, что оператор рождения легкого (L) и тяжело о (H) экситова с импульсом k и спиральностью $\sigma = \pm 1$ равен

$$\begin{cases} X_{H\sigma}^{+}(\vec{k}) \\ X_{L\sigma}^{+}(\vec{k}) \end{cases} \\ \begin{cases} = \sum_{\vec{p}_{e}, \vec{p}_{h}} \delta_{\vec{k}, \vec{p}_{e} + \vec{p}_{h}} \tilde{\phi}_{1S}(\vec{ap}_{h} - \beta\vec{p}_{e}) & \sum_{s_{e} = -1/2} S_{s_{e} = -3/2} \\ s_{e} = -1/2 S_{h} = -3/2 \end{cases}$$

19

$$\times \left\{ \begin{array}{ccc} D^{1/2} & (Oz \to \vec{k}) D^{3/2} & (Oz \to \vec{k}) \\ -\frac{1}{2}\sigma, s, & \frac{3}{2}\sigma, s_{h} \\ D^{1/2} & (Oz \to \vec{k}) D^{3/2} & (Oz \to \vec{k}) \\ \frac{1}{2}\sigma, s, & \frac{1}{2}\sigma, s_{h} \end{array} \right\} e^{+}_{s}(\vec{p}_{g}) h^{+}_{s}(\vec{p}_{h}).$$
(1)

Легко также вычислить эффективные константы связи квантового перехода тяжелого и легкого экситона в фотон и получить

$$g_{H} = g, \quad i; L = \frac{1}{\sqrt{3}} g,$$

$$g = \frac{1}{\sqrt{2\epsilon_{0}E_{i}}} \cdot \frac{e \Pi_{cv}}{m_{0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi a_{Ex}^{3}}},$$
(2)

где E_g -- ширина запрещенной зоны, ϵ_0 — статическая диэлектрическая константа полупроводника, е и m_0 — заряд и масса свободного электрона, a_{Ex} — боровский радиус экситона:

$$a_{Ex} = \frac{\epsilon_0}{m_r e^2}$$
,
П_{сv} — матричный элемент междузонного квантового перехода:

$$\Pi_{cv} = \langle S \mid \nabla_x \mid X \rangle = \langle S \mid \nabla_y \mid Y \rangle = \langle S \mid \nabla_z \mid Z \rangle.$$

Поляритонный спектр имеет три ветви, различающиеся индексом: $\nu = 1, 2, 3$. Операторы рождения поляритонов получаются посредством знаменитого преобразования Боголюбова:

$$\pi_{\nu\sigma}^{+}(\vec{k}) = \iota_{\nu}(k) \gamma_{\sigma}^{+}(\vec{k}) + v_{\nu H}(k) X_{H\sigma}^{+}(\vec{k}) + v_{\nu L}(k) X_{L\sigma}^{+}(\vec{k}).$$
(3)

Энергия $\Omega_{\nu}(\mathbf{k})$ поляритона на ветви ν определяется уравнением

$$\frac{\omega(k)^{2}}{\Omega_{\nu}(k)^{2}} = 1 + 4g^{2} \left\{ \frac{1}{E_{H}(k)^{2} - \Omega_{\nu}(k)^{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{E_{L}(k)^{2} - \Omega_{\nu}(k)^{2}} \right\}, \quad (4)$$

где $\omega(k)$ — энергия свободного фотона в среде, $E_{H}(k)$ и $E_{L}(k)$ — энергии тяжелого и легкого экситонов соответственно. Коэффициенты преобразования Боголюбова равны

$$u_{\nu}(k) = \left[\left[\left[E_{H}(k) - \Omega_{\nu}(k) \right]^{2} + \frac{1}{3} \frac{g^{2}}{\left[E_{L}(k) - \Omega_{\nu}(k) \right]^{2}} \right]^{-1/2},$$
(5)

$$v_{\nu H}(k) = \frac{g}{E_{H}(k) - \Omega_{\nu}(k)} u_{\nu}(k),$$
$$v_{\nu L}(k) = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{g}{E_{L}(k) - \Omega_{\nu}(k)} u_{\nu}(k).$$

Полученные выше результаты будем применять в последующих работах при изучении РКР света различными квази астицами в кубических полупроводниках с данной структурой энергетических зон. Приведем здесь лишь некоторые частные результаты. Рассмотрим сначала процесс РКР поляризованного света фотонами $^{/5-7/}$:

$$\pi_{\nu\sigma}(\vec{k}) \rightarrow \pi_{\nu'\sigma}, (\vec{k'}) + \phi(\vec{q}), \qquad (I)$$

где $\phi(\vec{q})$ обозначает фотон с импульсом \vec{q} . Его, дисуференциальное эффективное сечение обозначим через $W^{\sigma\sigma}_{\nu\nu}(\theta)_{[}$, где θ — угол рассеяния. В резонансной области, когда коэф рициенты $u_{...}(k)$ пренебрежимо малы, мы имеем соотношение

$$\frac{W_{\nu\nu}^{++},(\theta)_{I}}{W_{\nu\nu}^{+-},(\theta)_{I}} = \frac{U_{\nu\nu}^{(+)},(\theta)_{I}}{U_{\nu\nu}^{(-)},(\theta)_{I}},$$
(6)

где

$$U_{\nu\nu}^{(\pm)}, (\theta)_{I} = \{ v_{\nu'H}(k') v_{\nu H}(k) (1 \pm \cos \theta)^{2} + \{ v_{\nu'H}(k') v_{\nu L}(k) + v_{\nu'L}(k') v_{\nu H}(k) \} \sin^{2} \theta + \{ \frac{1}{3} v_{\nu'L}(k') v_{\nu L}(k) (\cos \theta \pm 1) (3\cos \theta \mp 1) \}^{2}.$$
(7)

Аналогично для дифференциального эффективного сечения $W_{\nu\nu}^{\sigma\sigma}$, $(\theta)_{II}$ процесса РКР поляризованного света электронами нейтральных доноров / 9-11/

$$\pi_{\nu\sigma}(\vec{k}) + e_{N} \rightarrow \pi_{\nu'\sigma'}(\vec{k'}) + e_{N}$$
(II)

в резонансной области мы имеем соотношение

$$\frac{W_{\nu\nu}^{++}(\theta)_{II}}{W_{\nu\nu}^{+-}(\theta)_{II}} = \frac{U_{\nu\nu}^{(+)}(\theta)_{II}}{U_{\nu\nu}^{(-)}(\theta)_{II}},$$
(8)

$$U_{\nu\nu}^{(\pm)}, (\theta)_{II} = \frac{1 \pm \cos\theta}{2} \{ [v_{\nu'H}(k')v_{\nu H}(k)]^{2} (1 \pm \cos\theta)^{2} + 3([v_{\nu'H}(k')v_{\nu L}(k)]^{2} + [v_{\nu'L}(k')v_{\nu H}(k)]^{2}) \sin^{2}\theta + (9) + [v_{\nu'L}(k')v_{\nu L}(k)]^{2} (3\cos\theta \mp 1) \}.$$

Эти теоретические предсказания весьма желательно проверить экспериментально.

Проблема резонансного комбинационного рассеяния будет рассмотрена подробно в отдельной работе.

ЛИТЕРАТУРА

гле

- 1. Пекар С.И. ЖЭТФ, 1957, т.33, вып.4, с.1022-1036.
- 2. Hopfield J.J. Phys. Rev., 1958, v.112, No.5, p.1555-1567.
- 3. Агранович В.М. Теория экситонов. М.: Наука, 1968.
- 4. Давыдов А.С. Теория молекулярных экситонов. М.: Наука, 1968.
- 5. Рассеяние света в твердых телах. Вып. 1 (под редакцией Кардоны М.). М.: Мир, 1979; Вып.III (под редакцией Кардоны М. и Гюнтерода Г.). М.: Мир, 1985.
- 6. Экситоны (под редакцией Рашба Э.И. и Стерджа М.Д.). М.: Наука, 1985.
- 7. Honerlage B. et al. Phys.Rep., 1985, v.124C, No.3, p.161-253.
- 8. Hoang Ngoc Cam, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ai Viet. Ann. Phys. (N.Y.), 1985, v.104, No.1, p.172-188.
- 9. Yu P.Y. Phys. Rev., 1979, v. B20, No.12, p.5286-5291.
- 10. Ulbrich R.G., Nguyen Van Hieu, Weisbuch C. Phys.Rev.Lett., 1981, v.46, No.1, p.5.³-57.
- Nguyen Bi An et al. Phys.Stat.Sol.(b), 1980, v.99, No.2, p.635-641; Phys.Stat.Sol.(b), 1982, v.109, No.1, p.463-472; Phys.Rev. 1982, v.B25, No.6, p.4075-4080.

Рукопись поступила 5 января 1988 года.

22

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ К СБОРНИКАМ

"КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ОИЯИ", №1/21/-6/26/, 1987

№1/21/

Ю.А.Батусов и др. Аннигиляция остановившихся антипротонов в Не и Не
/На английском/5
А.М.Балдин и др. Струи адронов в глубоконеупругих $\tilde{\nu}$ N-взаимодей- ствиях и универсальность их характеристик в прост- ранстве 4-мерных относительных скоростей /На английском/17
К.Д.Толстов К аномалонной трактовке столкновений ⁴⁰ Ar+Cu при энергиях 0,9 и 1,8 ГэВ на нуклон26
Ф.С.Садыхов Квантовохромодинамическое исследование процесса электророждения пионов на нуклоне и структурных функций нуклонов34
Ю.В.Борисов и др. Измерение электрического заряда нейтрона при помощи ультрахолодных нейтронов
Р.В.Джолос, В.П.Пермяков Влияние колебаний формы ядер на сечение под- барьерного слияния46
N°2/22/
А.М.Балдин, А.О.Кечечян, Б.А.Шахбазян О существовании первой промежуточной асимптотики в релятивистских ядерных столкновениях /На английском/4

Л.С. Охрименко, Б.Словински, А.Н.Ильина
Распределения по относительной 4-скорости π° - и
η° мезонов, образованных в π^- Хе-взаимодействиях
при импульсе 3,5 ГэВ/с12
Ф.Никитиу, В.А.Романов, С.В.Трубников
Фазовые анализы NK-рассеяния и магнитный
момент Л-гиперона23
Фам Ле Киен, А.С.Шумовский
0 кинетическом уравнении для двухмодового
лазера /Ча английском/ 28
/ nd dhi JINUCKOM/ ,
И.Ф Колпаков, А.Е.Сеннер, В.А.Смирнов
Суперкомпьютер ОИЯИ модульного типа для парал-
лельного анализа событий
В.В Пупышев
Регуляризация интегродифференциальных уравнений
Фаддеева по угловым переменным
/На английском/45
102 / 02 /
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
А.Т.Филиппов
0 локализации канонических преобразований в
теории релятивистских частиц

А.Н.Сисакян и др. Инфракрасные особенности фермионного пропагатора и и: связь с петлей Вильсона /На английском/.....12

 С.И.Виницкий, В.И.Коробов, И.В.Пузынин Уточнение уровней энергии слабосвязанных врашательно-колебательных состояний мезомолекул Э.Ф.Хефтер, В.Г.Картавенко Эволюция холодного сжатого ядерного вещестза В.А.Кузьмин Вычисление энергетически-взвешенных моментов Н.Н.Боголюбов /мл./, П.А.Поляков, М.А.Тасев Теория радиационного затухания электромагнитных волн в релятивистской магнитоактивной плазме в приближении "горячей" гидродинамики......41 r4/24/ Д.Армутлийски и др. Универсальность свойств четырехмерных барионных кластеров в адрон-ядерных и ядро-ядерных взаимодействиях в интервале энергий 4 ÷ 40 ГэВ...5 Е.Б.Докукин и др. Влияние поглощающего подслоя на поляризующую В.В.Пупышев Приближенные диоференциальные уравнения фаддеевского типа для систем из одной легкой и двух тяжелых частиц А.В.Тараканов, В.М.Шилов Неупругое рассеяние и слияние тяжелых ионов при околобарьерных и подбарьерных В.Вагнер и др. Спектрометрия характеристического рентгеновского

излучения_хери нейтрализации водородоподобных ионов Кг' Г.Д.Адеев, В.В.Пашкевич, О.И.Сердюк Влижние механизма ядерной вязкости на формиро-№5/25/ Г.С.Аверичев и др. Наблюдение кумулятивных антипротонов,.....4 М.Надь, В.С.Суяров, М.К.Волков Глюрний и скалярные мезоны /На английском/.....11 С.А.Карамян, А.В.Рыхлюк, В.Н.Бугров Аномальная зависимость повреждающей способности от Z иона при взаимодействии с монокристаллом Ge.....18 В.Г.Маханьков, Х.Т.Холмуродов Чиспенное моделирование устойчивости векторных В.М.Микляев, И.А.Сергеев, Ю.П.Филиппов Турбулизация сверхтекучего гелия в кольцевых каналах при нестационарных тепловых Нгуен Ван Хьеу и др. Электронное спаривание в изотропных сверхпроводниках с эффективным электронно-электронным

№6/26/

А.И.Иванов и др. Измерение массы электрона с помощью узкой компоненты пика аннигиляционного излучения....4

J I N R RAPID COMMUNICATIONS - 1987 CONTENTS

No.1/21/

Yu.A.Batusov et al. Annihilation of Stopping Antiprotons in "He and A.M.Baldin et al. Hadron Jets in Deep-Inelastic $\tilde{\nu}$ N Interactions and Universality of the Jet Properties in Relative Four-Velocity Space......17 K.D.Tolstov About Anomalon Interpretation of ⁴⁰Ar+Cu Collisions at [.9 and 1.8 GeV per Nucleon Energies. F.S.Sadykhov Quaritum Chromodynamic Investigation of the Pion Electroproduction on the Nucleon and the Nucleon Structure Functions. Yu.V.Borisov et al. Investigation of the Possibility of Neutron Electric Charge Measurement by Means of Ultracold Neutrons. R.V.Jolos, V.P.Permyakov The Effect of Nuclear Shape Oscillations on the Subbarrier Fusion Cross Section.

No.2#22/

A.M.Baldin, A.O.Kechechyan, B.A.Shahbazian

On the Existence of the First Intermediate

Asymptotics in Relativistic Nuclear L.S.Okhrimenko, B.Słowinski, A.N.Ilyina Relative Four-Velocity Distributions of π° ... and η° -Mesons Produced in the Reaction π^{-} Xe at 3.5 GeV/c. F.Nichitiu, V.A.Romanov, S.V.Trubnikov NK-Scattering Phase Analysis and Λ -Hyperon Magnetic Moment. Fam Le Kien, A.S.Shumovsky I.F.Kolpakov, A.E.Senner, V.A.Smirnov JINR Supercomputer of the Module Type for the Event Parallel Analysis. V.V.Pupyshev Regularization of Integrodifferential No.3/23/ A.T.Filippov Gauging of Canonical Transformation in the Relativistic Particle Theory. A.N.Sissakian et al. Infrared Singularities of Fermion Propagator N.B.Skachkov, O.Yu.Shevchenko The Lorentz Condition as a Secondary Gauge Condition and Its Application

S.I.Vinitsky, V.I.Korobov, I.V.Puzynin More Accurate Calculation of the Energy Levels of Weakly Bound Rotation-Vibrational States of Mesic Molecules dd μ and dt μ . E.F.Hefter, V.G.Kartavenko Evolution of Cold Dense Nuclear Matter......29 V_A.Kuzmin Evaluation of the Energy-Weighted Moments in the Random Phase Approximation. N.N.Bogolubov, Jr., P.A.Polyakov, M.A.Tassev The Theory of Radiative Attenuation of Electromagnetic Waves in Relativistic Magnetoactive Plasma in Hot Hydrodynamics Approximation. /In Russian/......41 No_4/24/ D.Armutlijski et al. Universality of 4-Dimensional Baryonic Cluster Properties in Hadron-Nuclear and Nucleus-Nuclear Interactions within the 4 - 40 GeV/c Energy Range. E.B.Dokukin et al. Influence of an Absorbing Sublayer on Polarizing Property of Magnetic Neutron Mirrors. V.V.Pupyshev Approximate Differential Faddeev-Type Equations for Systems of One Light

and Two Heavy Particles..... A.V.Tarakanov, V.M.Shilov Inelastic Scattering and Fusion of Heavy Ions at Near- and Subbarrier Energies. W.Wagner et al. Spectrometry of Characteristic X-Ray zet Hydrogen-Like Ion Neutralization Kr . G.D.Adeev, V.V.Pashkevich, O.I.Serdyuk The Influence of Mechanism of Nuclear Viscosity of Fission Fragment Distribution Formation. No.5/25/ G.S.Averichev et al. Cumulative Antiproton Observation. /In Russian/......4 M.Nagy, V.S.Suyarov, M.K.Volkov Gluonium and Scalar Mesons......11 S.A.Karamian, A.V.Rykhlyuk, V.N.Bugrov Anomalous Dependence of the Damage Power of Z Ions at the Interaction with Ge Single Crystal. /In Russian/.....18 V.G.Makhankov, Kh.T.Kholmurodov Numerical Study of Stability of Vector U(2)-Solitons /In Russian/......25 V.M.Miklyaev, I.A.Sergeyev, Yu.P.Filippov Superfluid Turbulence in Helium in Annuli

Channels at Transient Heat Fluxes. Nouven van Hieu et al. Electron Pairing in Isotropic Superconductors with Spin-Dependent Effective Electron-Electron Interaction. No.6/26/ A.I.Ivanov et al. Measurement of Electron Mass by Means of Narrow Component of Annihilation Radiation Peak. N.P.Basyleva et al. Application of VME Bus and a "Pravets-16" PC in a Subsystem of the Superconducting Synchrotron Cycle Control. /In Russian/.....12 Fam Le Kien Coherent-Trapping States of Three-Level Two-Mode E.K.Bashkirov, Fam Le Kien, A.S.Shumovsky Spontaneous Radiation of Two-Level Atoms with Multiphoton Transitions. E.K. Bashkirov, A.S. Shumovsky Kinetics of the Superradiation in the Three-Level System Allowing for the Two-Photon Transitions.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К СБОРНИКАМ

"КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ СИЯИ" №1/21/-6/26/, 1987

Аверичев, Г.С. - N5, с.4 Адеев, Г.Д. - №4, с.51 Армутлийски, Д. - №4, с.5 Базылев, С.Н. - №6, с.12 Базылева, Н.П. - №6, с.12 Балдин, А.М. - №1, с.17 - Nº2, c.4 - N4. c.5 Балестра, Ф. - №1, с.5 Батусов, Ю.А. - №1, с.5 Башкиров, Е.К. - №6, с.22 - Nº6, c.28 Бендишиоли, Г. - №1, с.5 Боголюбов, Н.Н./мл./ - N3, c.41 Бондарев, В.К. - №5, с.4 Борисов, Ю.В. - N1, с.40 Боровикова, Н.В. - N1, c.40 Боссоласко, С. - М1, с.5 Брейвик, Ф.О. - №1, с.5 Бугров, В.Н. - №5, с.18 Бунятов, С.А. - 171, с.5 Бусса, M.П. - №1, с.5 Буссо, Л. - №1, с.5 Вагнер, В. - №4, с.42 Васильев, А.В. - №1, с.40 Виницкий, С.И. - №3, с.24 Волков, М.К. - №5, с.11 Вылов, Ц. - №6, с.4 Горожанкин, В.М. - №6, с.4 Григорьева, Л.А.№4, с.5 - Nº1, c.40 Гришин, В.Г. - №1, с.17 - Nº4, c.5 Гуаральдо, К. - №1, с.5 Джолос, Р.В. - №1, с.46 Диденко, Л.А. - №1, с.17 №4, c.5

Докукин, Е.Б. #4. c.22 Донец, Е.Д. - №4, с.42 Дунин, В.Б. - №4. с.42 Ефимов, Л.Г. - NG, c.12 Зарубин, П.И. - ME, c.4 Зенони, А. - №1, с.5 Иванов, А.И. - NE. c.4 Иванов, С.Н. - N1. c.40 Ильина, А.Н. -№2, c.12 Карамян, С.А. - Nº5, c.18 Картавенко, В.Г. - №3, c.29 Карташов, С.В. - Nº4. c.42 Кашукеев, Н.Т. - N1. c.40 Кечечян, А.О. - M2, c,4 Колпаков, И.Ф. - Nº2, c.35 - №6. c.12 Корнеев, Д.А. - M4. c.22 Коробов, В.И. - M3, c,24 Кузнецов, А.А. - M1, c.17 - Nº4, c.5 Кузьмин, В.А. - 1º3, c.36

Лебедев, Н.А. - №6, с.4 Лебнер, В. - №4, с.22 Литвиненко, А.Г. - N5. c.4 Лоци Риццини, Э. - №1, c.5 Маджора, А. - №1, с.5 Манева Г.М. - №1, с.17 Маханьков, В.Г. - 125, c.25 Метревели, З.В. - N1, c.17 - #4, c.5 Миклебост, К. - №1, с.5 Микляев, В.М. - №5. с.31 Мозелев, А.А. - №5, с.4 Mopos, H.C. - №5, c.4 Нады, М. - №5, с.11 Нгуен Ан Вьет - N5, с.39 Нгузн Ван Хьеу - №5, c.39 Нгузн Тоан Тханг - N5, c.39 Несзижевский, В.В. - M1, c.40 Никитиу, Ф. - №1, с.5 - N², c.23 Никнооров, А.С. - N6, c.12 Олсэн, Дж. - №1, с.5 Охрименко, Л.С. - M2, c,12 Панебратцев, Ю.А. - Nº5, c.4 Панциери, Д. - №1, с.5 Пасок, В.В. - №4, с.22 Пашкевич, В.В. - №4, с.51 Пенця, М. - №5, с.4 Перевозчиков, В.Г. - №5, c.4 Пермяков, В.П. - №1, с.46

Петренко, А.В. - №4, c.22 Пираджино, Г. - M1. c.5 Покровский, В.Н. $- N_{6}, c.4$ Поляков, П.А. - №3, с.41 Понтекорво, Д.Б. - №1, c.5 Простаков, И.А. - 1.6, c.4 Пузынин, И.В. - №3, c.24 Пупышев, В.В. - N2, c.45 - Nº4, c.31 Ржаны, Х. - №4, с.22 Рихвицкий, С.В. - 175, c.4 Романов, В.А. - N2, c.23 Ротонди, А. - №1, с.5 Рыхлюк, А.В. - №5, с.18 Садыхов, Ф.С. - Nº1, c.34 Сальвини, П. - №1, с.5 Сапожников, М.Г. - №1, c.5 Сеннер, А.Е. - №2, с.35 - N°6, c.12 Сергеев, И.А. - №5, c.31 Сердюк, О.И. - Nº4, c.51 Серебров, А.П. - Nº1, c.40 Сисакян, А.Н. - №3, c.12 Скачков, Н.Б. - 1°3, c.12 - №3, c.17

Слепнев, В.М. - №6, с.12 Словински, Б. - N2, с.12 Смирнов, В.А. - №2, с.35 - №6, c.12 Соловцов, И.Л. - N3, с.12 Соренсен, С.О. - №1, с.5 Ставинский. В.С. - №5, c.4 Суяров, В.С. - №5, с.11 Тараканов, А.В. - №4, с.37 Тасев, М.А. - №3, с.41 Темников, П.П. - №1, с.17 Тозелло, Ф. - №1, с.5 Толстов, К.Д. - N²1, с.26 Третьяк, В.И. - №1, с.5 Трубников, С.В. - №2, с.23 Учеваткин, И.Ф. - №6, с.4 Фава, Л. - №1, с.5 Фаломкин, И.В. - №1, с.5 Фам Ле Киен ~ №2, с.28 - N°6, c.17 - N6, c.22 Ферреро, Л. - №1, с.5 Филиппов, А.Т. - №3, с.5 Филиппов, Ю.П. - №5, с.31 Хаатуют, А. - № 1, с.5 Ха Вин Тан - №5, с.39 Халштейнслид, А. - №1, c.5 Хеотер, Э.Ф. - N'3, с.29 Холмуродов, Х.Т. - Nº5, c.25 Хренов, А.Н. ~ №5, с.4 Шахбазян, Б.А. - №2, с.4 Шевченко, 0.Ю. - №3, с.12 - №3, c.17 Шилов, В.М. - №4, с. 37 Шумовский, А.С. - №2, c.28 - N6, c.22 - Nº6, c.28

Яйджиев, П.С. - №1, с.40 Якобсен, Т. - №1, с.5

Adeev, G.D. - No.4, p.51 Armutlijski, D. - No.4, p.5 Averichev, G.S. - No.5, p.4. Baldin, A.M. - No.1, p.17 - No.2, p.4 - No.4, p.5 Balestra, F. - No.1; p.5. Bashkirov, E.K. - No.6, p.22 - No.6, p.28 Basylev, S.N. - No.6, p.12 Basyleva, N.P. - No.6, p.12 Batusov, Yu.A. - No.1, p.5 Bendiscioli, G. - No.1, p.5 Bogolubov, N.N.(Jr.) - No.3, p.41 Bondarev, V:K. - No.5, p.4 Bor sov, Yu.V. - No.1, p.40 Borovikova, N.V. - No.1, p.40 Bossolasco, S. - No.1, p.5 Breivik, F.O. - No.1, p.5 Bug ov, V.N. - No.5, p.18 Bunyatov, S.A. - No.1, p.5 Bussa, M.P. - No.1, p.5 Busso, L. - No.1, p.5 Didenko, L.A. - No.1, p.17 - No.4, p.5 Dokukin, E.B. - No.4, p.22 Donets, E.D. - No.4, p.42 Dunin, V.B. - No.4, p.42 Efimov, L.G. - No.6, p.12 Falomkin, I.V. - No.1, p.5 Fam Le Kien - No.2, p.28 - No.6, p.17 - No.6, p.22 Fava, L. - No.1, p.5 Ferrero, L. - No.1, p.5 Filippov, A.T. - No.3, p.5 Filippov, Yu.P. - No.5, p.31 Gorozhankin, V.M. - No.6, p.4 Grigorieva, L.A. - No.1, p.40 Grishin, V.G. - No.1, p.17 - No.4, p.5 Guaraldo, C. - No.1, p.5 Haatuft, A. - No.1, p.5 Halsteinslid, A. - No.1, p.5 Ha vinh Tan - No.5, p.39 Hefter, E.F. - No.3, p.29 Ilyina, A.N. - No.2, p.12 Ivanov, A.I. - No.6, p.4

Ivanov, S.N. - No.1, p.40 Jacobsen, T. - No.1, p.5 Jolos, R.V. - No.1, p.46 Karamian, S.A. - No.5, p.18 Kartashov, S.V. - No.4, p.42 Kartavenko, V.G. - No.3, p.29 Kashukeev, N.T. - No.1, p.40 Kechechyan, A.O. - No.2, p.4 Kholmurodov, Kh.T. - No.5, p.25 Khrenov, A.N. - No.5, p.4 Kolpakov, I.F. - No.2, p.35 - No.6, p.12 Korneev, D.A. - No.4, p.22 Korobov, V.I. - No.3, p.24 Kuzmin, V.A. - No.3, p.36 Kuznetsov, A.A. - No.1, p.17 - No.4, p.5 Lebedev, N.A. - No.6, p.4 Litvinenko, A.G. - No.5, p.4 Löbner, W. - No.4, p.22 Lodi Rizzini, E. - No.1, p.5 Makhankov, V.G. - No.5, p.25 Metreveli, Z.V.- No.1, p.17 - No.4, p.5 Maggiora, M. - No.1, p.5 Maneva, G.M. - No.1, p.17 Miklyaev, V.M. - No.5, p.31 Moroz, N.S. - No.5, p.4 Mozelev, A.A. - No.5, p.4 Myklebost, K. - No.1, p.5 Nagy, M. - No.5, p.11 Nesvizhevsky, V.V. - No.1, p.40

Nguyen ai Viet - No.5, p.39 Nguyen toan Thang - No.5, p.39 Nguyen van Hieu - No.5, p.39 Nichitiu, F. - No.1, p.5 - No.2, p.23 Nikiforov, A.S. - No.6, p.12 Okhrimenko, L.S. - No.2, p.12 Olsen, J. - No.1, p.5 Panebrattsev, \u.A. - No.5, p.4 Panzieri, D. - No.1, p.5 Pashkevich, V.\. - No.4, p.51 Pasyuk, V.V. - No.4, p,22 Pentia, M. - Nc.5, p.4 Perevozchikov, V.G. - Nc.5, p.4 Permyakov, V.P. - Nc.1, p.46 Petrenko, A.V. - Nc.4, p.22 Piragino, G. - No.1, p.5 Pokrovsky, V.N. - No.6, p.4 Polyakov, P.A. - No.3, p.41 Pontecorvo, G.B. - No.1, p.5 Prostakov, I.A. - No.6, p.4 Pupyshev, V.V. - No.2, p.45 - No.4, p.31

Puzynin, I.V. - No.3, p.24 Rikhvitski, S.V. - No.5, p.4 Romanov, V.A. - No.2, p.23 Rotondi, A. - No.1, p.5 Rykhlyuk, A.V. - No.5, p.18 Rzany, H. - No.4, p.22 Sadykhov, F.S. - No.1, p.34 Salvini, P. - No.1, p.5 Sapozhnikov, M.G. - No.1, p.5 Serner, A.E. - No.2, p.35 - No.6, p.12 Serdyuk, 0.I. - No.4, p.51 Serebrov, A.P. - No.1, p.40 Sergeyev, I.A. - No.5, p.31 Shahbazian; B.A. - No.2, p.4 Shevchenko, 0.Yu. - No.3, p.12 - No.3, p.17 Shilov, V.M. - No.4, p.37 Shumovsky, A.S. - No.2, p.28 - No.6, p.22 - No.6, p.28 Sissakian, A.N. - No.3, p.12 Skachkov, N.B. - No.3, p.12 - No.3, p.17 Slepnyov, V.M. - No.6, p.12 Skowinski, B. - No.2, p.12

Smirnov, V.A. - No.2, p.35 - No.6, p.12 Solovtsov, I.L. - No.3, p.12 Sorensen, S.O. - No.1, p.5 Stavinsky, V.S. - No.5, p.4 Suyarov, V.S. - No.5, p.11 Tarakanov, A.V. - No.4, p.37 Tasseev, M.A. - No.3, p.41 Temnikov, P.P. - No.1, p.17 Tolstov, K.D. - No.1, p.26 Tosello, F. - No.1, p.5 Tretyak, V.I. - No.1, p.5 Trubnikov, S.V. - No.2, p.23 Uchevatkin, I.F. - No.6, p.4 Vasiliev, A.V. - No.1, p.40 Vinitsky, S.I. - No.3, p.24 Volkov, M.K. - No.5, p.11 Vylov, Ts. - No.6, p.4 Wagner, W. - No.4, p.42 Yajdzhiev, P.S. - No.1, p.40 Zarubin, P.I. - No.5, p.4 Zenoni, A. - No.1, p.5